

一般社団法人 半導体産業人協会
理事長 橋本浩一
講演企画委員長 有門経敏

第6回 SSIS フォーラム開催案内

平素、SSIS フォーラムにご出席いただき、厚くお礼申し上げます。2016年2月度フォーラムは下記の内容で開催する予定です。奮ってご出席、ご討論にご参加いただければ幸いです。

講演タイトル

「パワー半導体 SiC の研究開発と実用化へのみち」

講師

工学博士 松波 弘之氏（京都大学名誉教授）

< 講演要旨 >

SiCは高品質の結晶を成長させることが大変困難な材料であったが、1968年から研究を開始、20年の苦節を経て「ステップ制御エピタキシー」技術を開発、高品質結晶が成長できた。その後、ロームのショットキーダイオードの市販や京都大学・ローム・東京エレクトロンによる高品質エピ装置などの技術により、世界最高のパワーデバイスが開発されるようになった。最近では6インチウエハを用い、数kV級の高耐圧デバイスも開発され、Siに比較して大幅に電力効率の高いデバイスがIT機器用電源、高速鉄道・自動車などに搭載される電力変換システムに向け開発されつつある。

本講演では、SiC パワー半導体とデバイスを中心に、期待される理由、現状の技術、進展経緯、実用化へのステップ、などを中心に、課題と今後の展開を紹介する。低損失 SiC パワーシステムを用いて電力の有効利用を図って省エネルギーを達成することは、結果として、環境負荷を低減することに資するであろう。

< 講師紹介 >

松波 弘之 氏 京都大学名誉教授

1964年 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻修士課程修了

1971年 京都大学工学部助教授

1976-77年 米国ノースカロライナ州立大学客員准教授

1983年 京都大学工学部教授

1996年 京都大学工学研究科教授

2003年 京都大学名誉教授

2004-12年 (独)科学技術振興機構(JST) イノベーションプラザ京都館長

表彰 2001年 第1回山崎貞一賞、2002年 平成14年度 文部科学大臣賞（研究功績賞）

2004年 第41回電子情報通信学会 研究業績賞、2012年度朝日賞等受賞

< 開催要領 >

1. 日時 2016年2月25日(木) 17時30分～20時
2. 場所 林野会館(文京区大塚、地下鉄茗荷谷) 5F ホール
3. プログラム
17:30～19:00 講演 松波 弘之氏
「パワー半導体 SiC の研究開発と実用化へのみち」
19:00～20:00 交流会 (@林野会館 6F 604 号室)
4. 参加費
SSIS 会員 3,000 円(交流会込み)
非会員 4,000 円(講演のみ)
6,000 円(講演および交流会)

参加費は当日会場にて申し受けます。なお、会員でない方は日の入会が可能です。

5. 参加申し込み

SSIS 事務局行(FAX:03-6457-3246 E-Mail :info@ssis.or.jp でも承ります)

SSIS フォーラム 参加申込票

2月25日(木)の SSIS フォーラムに出席します。

お名前:

所属 :

連絡先:

区分 : SSIS 会員 []

非会員 [] ⇒ 講演のみ[]、講演および交流会[]

(該当する区分に○をお付け下さい)



SSIS フォーラムの情報および協会の活動の最新情報は、ホームページでご覧いただけます。

<http://www.ssis.or.jp>